附件1：

2020年第二批半导体材料国家标准项目计划

| 序号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准  性质 | 制修订 | 代替标准号 | 采标  情况 | 项目周期/个月 | 技术归口单位 | 主要起草单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源：《国家标准化管理委员会关于下达2020年第二批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发[2020] 37号），2020年8月7日 | | | | | | | | | |
|  | 20202826-T-469 | 碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 12 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 |
|  | 20202827-T-469 | 氮化硅粉体中氟离子和氯离子含量的测定 离子色谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 新特能源股份有限公司、新疆晶硕新材料有限公司 |
|  | 20202829-T-469 | 半绝缘碳化硅单晶的电阻率非接触测试方法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
|  | 20202830-T-469 | 碳化硅单晶位错密度的测试方法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
|  | 20202882-T-469 | 金属锗化学分析方法 第3部分:痕量杂质元素的测定 辉光放电质谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 广东先导稀材股份有限公司 |
|  | 20202892-T-469 | 硅单晶中氮含量的测定 二次离子质谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 |
|  | 20202918-T-469 | 氮化铝材料中痕量元素（镁、镓）含量及分布的测定 二次离子质谱法 | 推荐 | 制定 |  |  | 24 | 全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会 | 北京科技大学、中国科学院半导体研究所 |